

## ***References***

- [1] Ralph willians, Modern GaAs processing methods, 1990
- [2] M. Mizuta, M. Tachikawa, H. Kukimoto, S. Minomura, Jpn. J. Appl. Phys. 24 (1985) 5387
- [3] T. Kobayashi, K. Taira, F. Nakamua, H. Kawai, J. Appl. Phys. 65 (1989) 4898.
- [4] Manijeh Razeghi, “The MOCVD Challenge” Vol. 2.
- [5] J.M. Olson, R.K. Ahrekiel, D.J. Ahrenkiel, D.J. Dunlavy, Brian Keys, A.E. Kibbler, Appl. Phys. Lett 55(1989) 1208
- [6] E. Munoz, E. Calleja, I. Izpura, F. Garcla, A.L. romero, J.L. Sanchez-rojas, A.L. Powell, J. Castagne, J. Appl. Phys. 73 (1993) 4988
- [7] T.K. Sharma, M.R. Gokhale, B.M. Arora, J. Crystal growth. 213 (2000) 241
- [8] F.E.G. Guimaraes, B. Elsner, R. Westphalen, B. Spangenberg, H.J. Geelen, P. Balk, K. Heime, J. Crystal Growth 124 (1992) 199
- [9] C.Y.Tsai, M. Moser, C. Geng, V. Harle, T. Forner, P. Michler, A. Hangleiter, F. Scholz, J. Crystal Growth 145 (1994) 786.
- [10] T.K. Sharma, B.M. Arora, M.R. Gokhale, S. Rajgopalan, J. Crystal Growth 221 (2000) 509
- [11] T. Nakano, Y. Nakano, Y. Shimogaki, J. Crystal Growth 221 (2000) 136
- [12] T. Tanaka, T. Noda, S. Sakaki, Mater. Sci. Eng. B 14 (1992) 304.
- [13] Y.Q. Wang, Z.L. Wang, T. Brown, A. Brown, G. May, Thin Solid Films 397 (2001) 162

- [14] T. Chung, S. R. Bank, John Epple, K. C. Hsieh, IEEE on Electron Devices. Vol. 48. NO.5 May 2001
- [15] M. Behet, R. Hovel, A. Kohl, A. Mesquida Kusters, B. Opitz and K. Heime, J. Microelectronics 27 (1996) 297-334
- [16] A. G. Thompson, R. A. Stall and B. Kroll, Semiconductor Intern. (July 1994) 172
- [17] Gerald B. Stringfellow, “Organometallic Vapor-Phase Epitaxy Theory and Practice”.
- [18] H. Heinecke, E. Veuhoff, N. Putz, M. Heyen and P. Balk, J. Electron Mater., J. Electron Mater., 13 (194) 815
- [19] S. K. Ghandi and R. J. Field, J. Crystal growth, 69 (1984) 619
- [20] A. G. Thompson, Materials Lett. 30 (1997) 255
- [21] C. Y. Chang, Y. K. Su, M. K. Lee, L. G. Chen, M. P. Hung, J. Crystal Growth 55 (1981 ) 24.
- [22] J. P. Duchemin, J.P. Hirtz, M. Razeghi and S.D. Hersee, J. Crystal growth, 55 (1981) 64.
- [23] M. razeghi, “The MOCVD Chellenge” Vol. 1
- [24] M. Zorn, P. Kurpas, B. Junno, K. Knorr, M. Weyers, J. T. Zettler, L. Samuelson, W. Richter, to be published.
- [25] T. Kobayashi, K. Taira, F. Nakamua, H. Kawai, J. Appl. Phys. 65 (1989) 4898.
- [26] G. attolini, S. Scardova, F. Germini, C. Pelpso, O. Martinez, L.F. Sanz, M.A. Gonzalez, J. Jimenez, Materials. Sci. and Eng. B91 (2002) 123
- [27] P. M. Mooney, J. Appl. Phys. 67 (1990) R1.
- [28] K. Ozasa, M. Yuri, “ MOMBE of InGaO” J. Appl. Phys. 65 (7), 1

April, 1989.

- [29] G. B. Stringfellow, S. G. Chen, J. Vac. Sci. Technol. B 9 (1991) 2182.
- [30] M. Longo, A. Parisine, L. Tarricone, L. Toni, R. Kudela, Materials. Sci. and Eng. B86 (2001) 157.
- [31] A. Krost, N. Esser, H. Esser, H. Selber, J. Christen, W. Richter, D. Bimberg, L.C. Su, G.B. stringfellow, J. Vac.Sci. Technol. 12 (1994) 2558.
- [32] M. C. Delong, D. J. Mowbray, R. A. Hogg, M. S. Skolnick, M. Hopkinson, J. P. R. David, P. C. Taylor, S. R. Kurtz, J. M. Olson, J. Appl. Phys. 73 (1993) 5163
- [33] A. Sasaki, K. Tsuchida, Y. Narukawa, Y. Kawakami, S. G. Fujita, Y. Hsu, G. B. Stringfellow, J. Appl. Phys. 89 (2001) 343
- [34] A. Gomyo, T. Suzuki, K. Kobayashi, S. Kawata, I. Hino, T. Yuasa, Appl. Phys. Lett. 5. (1987) 673
- [35] M. Zorn, J. Jonsson, W. Richter, J. T. Zettler, K. Ploska, Phys. Stat. Sol. (a) 152 (1995) 23.
- [36] D. E. Aspnes, J. Vac. Sci. Technol. B 3 (1985) 1498
- [37] T. Ota, S. Otake, I. Iwasa, J Crystal Growth 133 (1993) 207.
- [38] T. Nittono, S. Sugitani, F.Hyuga, J Appl. Phys. 78 (1995) 5387
- [39] F. E. G. Guimaraes, B. Elsner, R. Westphalen, B. Spangenberg, H. J. Geelen, P. Balk, K. Heime, J. Crystal Growth 124 (1992) 199.
- [40] W. Prost, F. Scheffer, Q. Liu, A. Lindner, H. Lakner, I. Gyuro, F. J. Tegude, J. Crystl Growth 146 (1995) 538.
- [41] C. Y. Tsai, M. Moser, C. Geng, V. Harle, T. Forner, P. Michler, A. Huangleiter, F. Scholz, J. Crystal Growht 145 (1994) 786.

- [42] R. Bhat, M. A. Koza, M. J. S. P. Brasil, R.E. Nahory, C.J. Palmstrom, B. J. Wilkens, *J. Crystal Growth* 124 (1992) 576.
- [43] Y. Q. Wang, Z. L. Wang, T. Brown, A. Brown, G. May, *J. Electron . Mater.* 29 (2000) 1372.
- [44] R. Kudela, M. Kucera, B. Olejnikova, P. Elias, S. hasenohrl, J. Novak, *J. Crystal Growth* 212 (2000) 21.

